Local electron spectroscopy with voltage pulse scanning probe microscope

1. 研究背景

近年,電子デバイスの性能向上(高集積化や低消費電力化) の実現するための様々な微細加工技術が開発されてきた.微細加工では,加工技術そのものだけでなく,ナノスケールで の材料評価も重要となる.現在,代表的なナノスケールの材 料評価法には走査プローブ顕微鏡(SPM)が挙げられる.SPM は探針で試料をなぞることで表面の形状や物性を測定する 装置の総称であり,走査型トンネル顕微鏡(STM)⁽¹⁾や原子間 力顕微鏡(AFM)⁽²⁾が代表的な SPM として広く利用されてい る.また現在,これらの顕微鏡を基盤に様々な SPM が開発 されている^(3,4,5).これまで,我々の研究室でも AFM と高速 パルス電圧制御を組み合わせたパルス AFM の開発に成功し ている^(6,7).そこで研究では,本パルス AFM をさらに STM と 融合させて,以下の計測を実現可能なパルス AFM/STM (SPM)技術を開発することを目的とする.

- 2原子間の化学結合に伴う分子軌道形成の過程を局所状態密度(LDOS)の変化として原子分解能で測定可能な pulse-Scanning Tunneling Spectroscopy (pulse-STS)法.
- (2) AFM/STM 同時測定による表面の局所仕事関数(LWF)の 直接計測が可能な pulse-Local Work Function Microscopy (pulse-LWFM)法.

具体的に本研究では、上記の顕微鏡法の実現に向けて、pulse SPM 装置の構築,及び,構築した pulse SPM を用いた測定原 理(1),(2)の検証を行った.

2. pulse SPM の基本原理

2.1 装置の構成

本研究で開発したパルス SPM の装置構成を図1に示す. 装置は大きく SPM 部と電圧制御部に分けられる. SPM 部で は、局所障壁高さ(LBH)や局所電子状態密度(LDOS)等,試料 表面の電子物性を、トンネル電流を介して計測するため、導 電性カンチレバーを用いた.一方,電圧制御部では振幅V_p, 時間幅ω,の電圧パルスを一定振幅させたカンチレバーの振 動に同期(遅延時間 τ)させながら試料に印加する.

2.2 pulse-LWFM 法の原理

 V_p およびωは固定して、τをカンチレバーの振動周期内で 掃引させると、その際に流れるトンネル電流($I - \tau$ 曲線)は、 τを探針試料間距離 zに変換することで、I - z 曲線に変換で きる. このI - z 曲線をトンネル電流の理論式でフィッティ ングすると、フィッティングパラメータから従来の STM で 検出可能な局所トンネル障壁高さ(LBH)が得られる. 一方、 上記の操作を各々振幅± V_p で行うと、その際に得られるカン チレバー振動のエネルギー散逸から、従来の AFM(ケルビン プローブ力顕微鏡)で検出可能な局所接触電位差(LCPD)が得 られる. これら LBH と LCPD から探針と試料表面の LWF を 直接算出できる. これまでの研究で、LCPD の計測は既に実 現している. そこで、本研究では、残りの LWF 計測に注力 して、その原理実証を行った. 航空宇宙工学コース 稲見研究室 1255041 日笠 響貴



Fig. 1 Schematic diagram of pulse SPM system.

2.3 pulse-STS 法の原理

 τ を固定した状態で V_p を掃引させると、その際のトンネル 電流は、従来のSTSで得られるIVと同等の意味を持ち、そ こから解析的にLDOS(dl/dV)を評価できる.この測定を τ を 系統的に変化させながら行うと、特定のzにおける試料の LDOSを評価できる.先行研究⁽⁸⁾では、SPMの探針が試料表 面の原子と化学結合する領域にまで近接すると、探針先端原 子と表面原子の間に分子軌道が形成され、それがLDOSの変 化に反映されると予想している.本研究では、このような分 子軌道形成に伴うLDOSの変化を pulse-STS 法により直接検 出可能かを検証した.

3. 実験手順

パルス電圧の出力と SPM からの信号検出を行うために, 任意波形発生器(wx2182c,テイバー社製)と DAQ デバイス (USB-6001, National Instruments 社製)を一元的に制御可能な コントローラを作成した. コントローラの開発環境には LabVIEW (National Instruments 社製)を用いた.また, SPM プ ローブには Cr/Pt でコーティングした Si 製のカンチレバーを 用いた.pulse-STS 法と pulse-LWFM 法の原理実証のための テスト試料には, Si(111)-(7×7)表面を採用した.

4. 実験結果

4.1 LDOS の測定結果

図 2(a)に $\tau = 0 \sec l - 1 \times 10^{-7} \sec$, $\omega = 50$ ns $v_{\rm p}$ を掃引し て得られたI - V曲線を示す. $\tau = 0 \sec$ におけるzは探針先端 原子が表面原子と化学結合する領域まで近接した状況であ り, $\tau = -1 \times 10^{-7} \sec$ におけるzは探針先端原子が試料から 十分離れた状況に対応している. 図よりI - V曲線はどちら も右肩上がりの傾向にあるが,変化率が異なっている様子が 確認できる. ここで, I - V曲線の規格化を行い, 両曲線の形 状を比較した結果, 図 2(b)のように, 2 つの曲線は $V_{\rm p}$ に対し て明らかに異なる形状を示すことが明らかとなった.この結



Fig. 2 (a) I - V curves, (b) normalized I - V curves, (c) dI/dV curves measured by pulse SPM. In (a)-(c), red and blue curves indicate data measured at $\tau = 0 \sec, 1 \times 10^{-7} \sec$, respectively.



Fig. 3 I - z curve measured by pulse SPM. Solid red curve is the fit of data in the range of $z > 6.53 \times 10^{-11}$. Broken red curve is the extrapolation of the solid red curve.

果は、zの違いにより、試料の電子状態が変化したことを示唆 する.そこで、実際に2つのI-V曲線からLDOS(dl/dV)を評 価し、それらの形状を比較した結果を図2(c)に示す.図より2 つのdl/dVは異なる形状を示しているが、実際のLDOS以外 に数値微分に由来したと思われる振動信号が含まれており、 両者の分離はできなかった.

4.2 LBH の測定結果

 τ 掃引によって得られたI - z曲線を図 3 に示す. 図から、 トンネル電流は $z > 6 \times 10^{-11}$ mで、zに対して指数関数的に 減衰する様子を確認できる.しかしながら、 $z < 6 \times 10^{-11}$ m では、データが $z > 6 \times 10^{-11}$ mでの指数関数から逸脱するこ とが明らかとなった. 図中の赤破線は、 $z > 6.53 \times 10^{-11}$ m で、データを理論式でフィッティングした結果を示しており、 このフィッティングパラメータからは LBH が2.68±0.85 eV と評価された.

5. 得られた LDOS・LBH に関する考察

5.1 LDOS の測定結果に対する考察

図 2(b)より異なる z でI-Vの形状に違いが見出された. この結果は, 2.3 で述べた探針先端原子と表面原子の化学結合に由来すると考えられる.したがって,原理的に pulse-STS 法により 2 原子間の化学結合に伴う分子軌道形成過程を LDOS の変化として検出可能であると結論できる.

一方,本研究では,*I-V*曲線から実際のLDOSのピークが 特定できなかった。その理由として、ノイズの影響が考えら



Fig. 4 (a) I - z curves measured by pulse SPM (blue) and AFM/STM (red). (b)I - z curves measured by STM (blue) and AFM/STM (red). Blue and red dashed lines in (a) are fits of data measured by pulse SPM and AFM/STM, respectively. Blue dashed line in (a) is a fit of data measured by STM

れる。ノイズで本来の電子状態のピークが埋もれてしまった ことにより、dl/dVのピークを特定することができなかった。 そのため、今後は極低温環境などといった高 SN 比データが 取得可能な環境での測定が望まれる。

5.2 LBH の測定結果に対する考察

パルス SPM で得られた結果と文献値(3.5eV)^(3.9)より僅かに 小さい程度で良い一致を示している.この結果から,原理的 に,pulse-LWFM 法により,従来との STM と同様の LBH を検 出可能であると結論できる.

一方,図3では,z<6×10⁻¹¹mにおいて,データがトンネ ル電流理論に基づく指数関数形状から逸脱することが明ら かになった.この理由は、5.2節で述べた探針先端原子と表面 原子の化学結合に伴う LDOS の変化から説明できる.図 4(a),(b)は, それぞれ, STM, AFM/STM(振動カンチレバー), pulse SPM により計測した*I*-z曲線の形状を比較した結果を 示している. 図から, I-z曲線の形状は AFM/STM と pulse SPM で一致しているが, AFM/STM と STM では, z <-1×10⁻¹⁰ mで異なっている様子を確認できる.この結果は, AFM/STM および pulse SPM でトンネル電流を検出するzが, STM に比べて十分小さいためである. このようなzが小さな 領域では,探針先端原子と表面原子の化学結合が生じ,トン ネル電流が急落してしまう⁽³⁾. したがって,現状, pulse SPM で従来のSTMと同様のLBHを検出するには、図3に示すよ うに、十分大きなzの領域でデータをフィッティングする必要 がある. したがって, pulse-LWFM 法では,今後,フィッティン グ範囲の最適化と共に,zが十分大きな領域でトンネル電流 を高 SN 比で計測する条件を確立することが重要な課題に挙 げられる.

文献

- (1) G. Binnig, H. Rohrer, Ch. Gerber, and E. Weibel, Phys. Rev. Lett. 49, 57 (1982).
- (2) G. Binnig, C. F. Quate and Ch. Gerber, Phys. Rev. Lett. 56, 930 (1986).
- (3) D.Sawada, Y.Sugimoto, K.Morita, M.Abe, and S.Morita, Appl. Phys. Lett. 94, 173117 (2009)
- (4) Vatel, and M. Tanimoto, J. Appl. Phys. 77, 2358 (1995)
- (5) D. W. Pohl, W. Denk, and M. Lanz, Appl. Phys. Lett. 44, 651 (1984)
- (6) E. Inami and Y. Sugimoto, Phys. Rev. Lett. 114, 246102 (2015)
- (7) E. Inami and Y. Sugimoto, Jpn. J. Appl. Phys. 55, 08NB05 (2016)
- (8) P.Jelínek, M.Švec, P,Pou, R.Perez, and V.Cháb, PRL 101, 176101 (2008).
- (9) C. J. Chen, and R. J. Hamers, J. Vac. Sci. Technol. B. 9, 503 (1991).